Перечень победителей конкурса на получение грантов Российского научного фонда по выполнению ориентированных и прикладных научных исследований в рамках стратегических инициатив Президента Российской Федерации в научно-технологической сфере в области производства интегральных схем

п/п	Номе р	Номер заявки	Название проекта	Организация-победитель	
	лота				
1	1	23-91-06001	Разработка и внедрение технологии аттестации сверх чистых химических материалов для технологии микроэлектроники с проектными нормами от 65 нм. Шифр «Анализ-А1»		
2	2	23-91-06006	Разработка и внедрение технологии аттестации сверх чистых химических материалов для технологии микроэлектроники с проектными нормами от 65 нм. Шифр «Анализ-А2»	«СМИИН» ОА	
3	3	23-91-06007	Разработка и внедрение технологии аттестации сверх чистых химических материалов для технологии микроэлектроники с проектными нормами от 65 нм. Шифр «Анализ-А3»	АО «НИИМЭ»	
4	4	23-91-06009	Разработка и производство загрузчика (распаковщика) полупроводниковых пластин для производства интегральных схем (SMIF-загрузчика)	СПбГЭТУ «ЛЭТИ»	
5	5	23-91-06012	Исследование влияния легирующих элементов и покрытий материала проволочных выводов на процессы формирования интерметаллидов и надёжность микросварных соединений Al-Au и Al-Cu интегральных микросхем	АО «НИИМА «Прогресс»	
6	6	23-91-06011	Разработка технологии изготовления микропроволоки из Au и Cu, стойкой к интерметаллическим соединениям для сборки интегральных микросхем	АО «НИИМА «Прогресс»	
7	9	23-91-06000	Разработка технологии аналитических исследований элементов ЭКБ с резистивным переключением. Шифр «ЛеДа»	ИНМЭ РАН	
8	10	23-91-06004	Разработка процессов ALE, шифр «PEALE»	Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Московский университет или МГУ	
9	11	23-91-06008	Поисковое исследование методов предсказательного моделирования состояния ячеек энергонезависимой памяти на основе машинного обучения, шифр «Состояние-ИИ»	АО «НИИМЭ»	
10	12	23-91-06002	Исследование и разработка технологических процессов атомно-слоевого осаждения с использованием разрабатываемых в РФ материалов для современных технологий микроэлектроники, шифр «Атом-О»	АО «НИИМЭ»	
11	13	23-91-06003	Исследование и разработка технологических процессов формирования функциональных слоев методом ACO на основе оксидов переходных металлов для нового типа энергонезависимой ReRAM памяти с их апробацией для создания ячеек памяти в BEOL и FEOL, шифр «Память-Р»	АО «НИИМЭ»	
12	14	23-91-06005	Создание программного обеспечения для автоматизации проектирования и программирования гетерогенных реконфигурируемых интегральных схем	МИЭТ	